

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 1 区分

【発行日】平成22年3月18日 (2010.3.18)

【公表番号】特表2006-502843(P2006-502843A)

【公表日】平成18年1月26日 (2006.1.26)

【年通号数】公開・登録公報2006-004

【出願番号】特願2004-543948(P2004-543948)

【国際特許分類】

B 0 1 J 31/22 (2006.01)

C 0 7 C 67/303 (2006.01)

C 0 7 C 69/34 (2006.01)

C 0 7 C 231/12 (2006.01)

C 0 7 C 233/13 (2006.01)

C 0 7 C 233/47 (2006.01)

C 0 7 B 61/00 (2006.01)

【F I】

B 0 1 J 31/22 Z

C 0 7 C 67/303

C 0 7 C 69/34

C 0 7 C 231/12

C 0 7 C 233/13

C 0 7 C 233/47

C 0 7 B 61/00 3 0 0

【誤訳訂正書】

【提出日】平成22年1月29日 (2010.1.29)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】全文

【訂正方法】変更

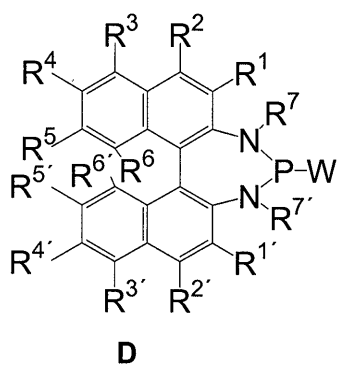
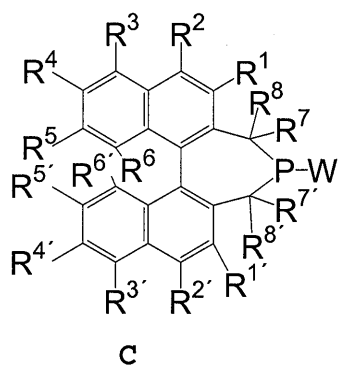
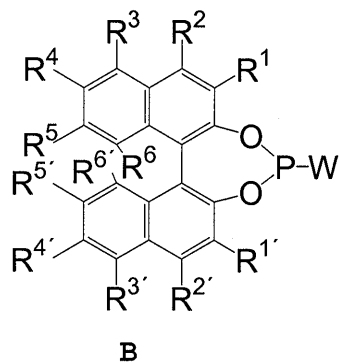
【訂正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

キラル遷移金属触媒の存在下でのプロキラル有機化合物の水素付加のための方法において、少なくとも 2 つの構造的に異なるモノホスフォラス配位子が金属に結合しており、そのうちの少なくとも 1 つのモノホスフォラス配位子がキラルであり、かつ、キラルなモノホスフォラス配位子が、下式 B、C 又は D タイプ

【化 1】



のモノホスフォラス化合物から選択されており、

ここで、Wは炭素(C)、窒素(N)、酸素(O)、硫黄(S)、又はハロゲン(F、Cl、Br、I)であり、そして更に原子もしくは原子団がその自由原子価の数に従ってWに結合しており、

そして、ここで R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 、 $R^{1'}$ 、 $R^{2'}$ 、 $R^{3'}$ 、 $R^{4'}$ 、 $R^{5'}$ 、 $R^{6'}$ 、 $R^{7'}$ 及び $R^{8'}$ 基は、それぞれ独立に水素、ハロゲン、飽和及び不飽和、直鎖状及び分岐状の $C_1 - C_{50}$ アルキル、 $C_1 - C_{50}$ アリール、 $C_1 - C_{50}$ ヘテロアリール、アルキニル、シリル、ニトロ、ニトリル、エステル、カルボキシル、カルボニル、アミド、アミン、ヒドロキシル、アルコキシ、スルフィド及びセレナイド基の群からなり、

ここで R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 、 $R^{1'}$ 、 $R^{2'}$ 、 $R^{3'}$ 、 $R^{4'}$ 、 $R^{5'}$ 、 $R^{6'}$ 、 $R^{7'}$ 及び $R^{8'}$ は、更に置換基を有していてもよく、また官能化されていてもよく、

かつ、遷移金属がRh、Ir、Ru、Ni、Pd又はPtである

ことを特徴とする方法。

【請求項 2】

請求項 1 で規定した方法において、少なくとも 2 つのモノホスフォラス配位子がキラルである方法。

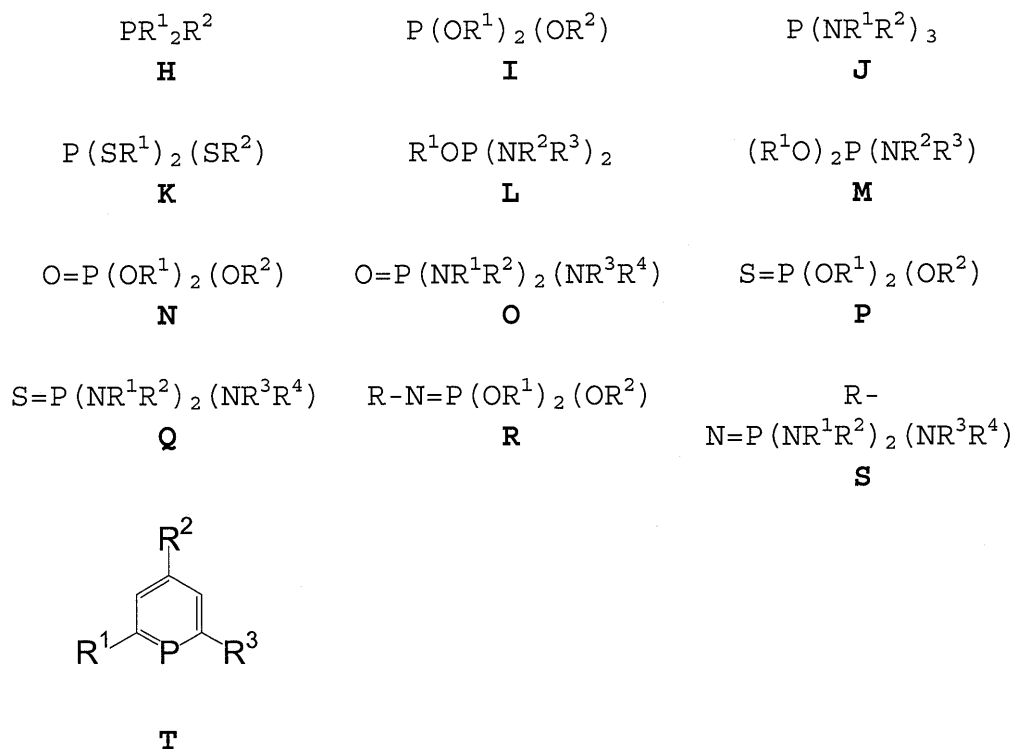
【請求項 3】

請求項 1 又は 2 で規定した方法において、モノホスフォラス配位子がホスフィン、ホスファイト、ホスフォナイト、ホスフィナイト、ホスフォラストリアミド、ホスフォラスモノエステルジアミド、ホスフォラスジエステルアミド、ホスフォナスジアミド、ホスフィナスアミド、ホスフォナスモノエステルアミド、ホスフォラスハライド、ホスフォラスジアミドハライド、チオホスファイト、チオホスフォラストリエステル、チオホスフォラスモノエステルジアミド、又はチオホスフォラスジエステルアミドである方法。

【請求項 4】

請求項 1 ないし 3 のいずれかで規定した方法において、少なくとも 1 つのアキラル配位子が下式 H から T タイプのモノホスフォラス化合物である方法。

【化 2】



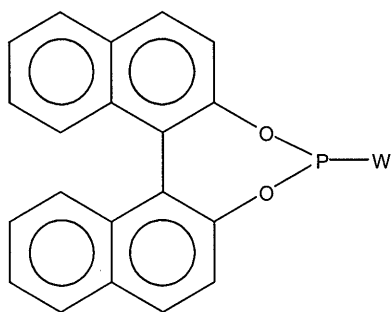
ここで、 R^1 、 R^2 、 R^3 及び R^4 基はそれぞれ独立に水素、ハロゲン、飽和及び不飽和、直鎖状及び分岐状の $\text{C}_1 - \text{C}_{50}$ アルキル、 $\text{C}_1 - \text{C}_{50}$ アリール、 $\text{C}_1 - \text{C}_{50}$ ヘテロアリール、アルキニル、シリル、ニトロ、ニトリル、エステル、カルボキシル、カルボニル、アミド、そしてセレナイド基の群からなり、

ここで R^1 、 R^2 、 R^3 及び R^4 は、更に置換基を有していてもよくまた官能化されていても架橋されていてもよい。

【請求項 5】

請求項 1 ないし 4 のいずれかで規定した方法において、用いるキラルモノホスフォラス配位子が少なくとも下記タイプの 2 つの配位子であることを特徴とする方法。

【化 3】



ここで、Wは、それぞれ独立に CH_3 、 $\text{C}(\text{CH}_3)_3$ 、 $\text{c-C}_6\text{H}_{11}$ 又は OCH_3 である。

【誤訳訂正 2】

【訂正対象書類名】明細書

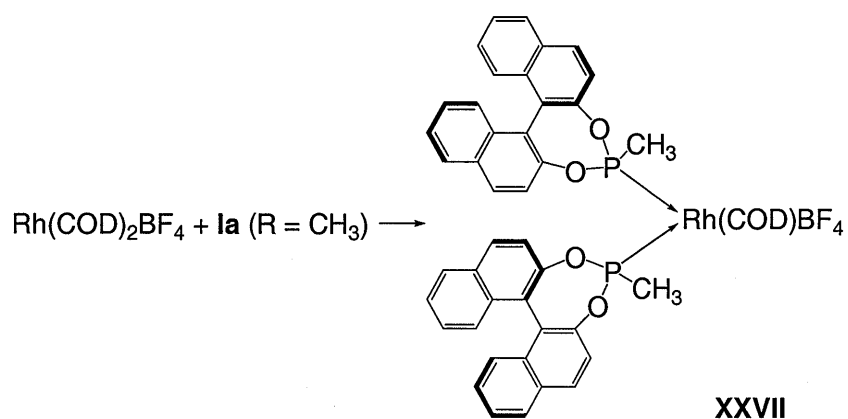
【訂正対象項目名】0046

【訂正方法】変更

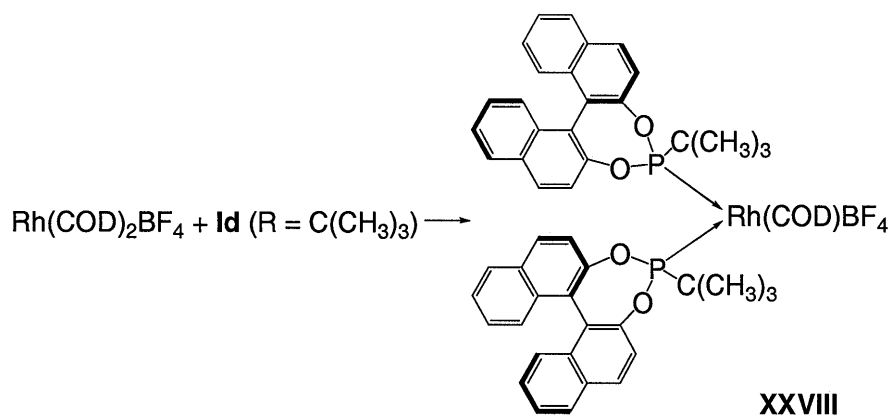
【訂正の内容】

【0046】

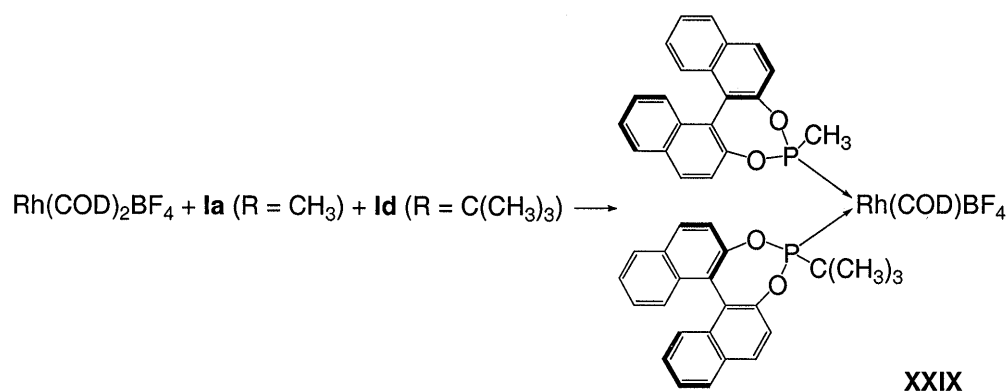
【化 19】



【化 20】



【化 2 1】



【誤訳訂正 3】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0050

【訂正方法】変更

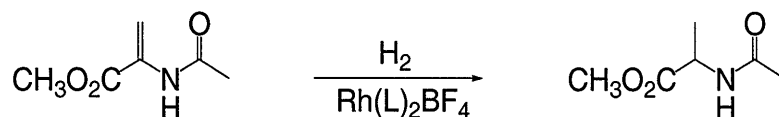
【訂正の内容】

【0050】

【実施例 1】

I、II 及び III タイプの配位子を用いてメチル N - アシルアクリレートの Rh - 触媒による水素付加反応

【化 2 2】



【誤訳訂正 4】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0053

【訂正方法】変更

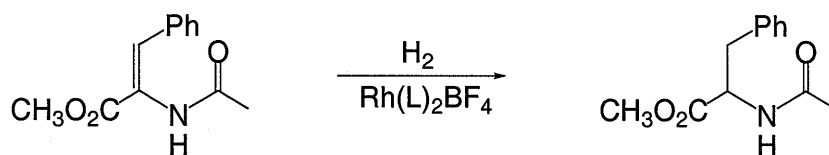
【訂正の内容】

【0053】

【実施例 2】

I タイプの配位子を用いてメチルフェニル - N - アシルアクリレートの Rh - 触媒による水素付加反応

【化 2 3】



【誤訳訂正 5】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0055

【訂正方法】変更

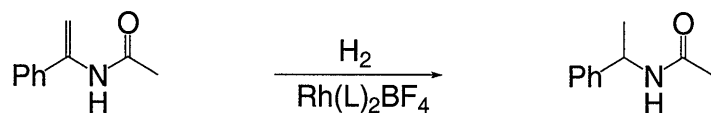
【訂正の内容】

【0055】

【実施例 3】

I と II タイプの配位子を用いて 1 - N - アシルアミノスチレンの Rh - 触媒による水素付加反応

【化 2 4】



【誤訳訂正 6】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 5 8

【訂正方法】変更

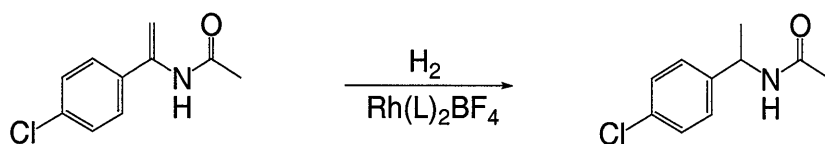
【訂正の内容】

【0 0 5 8】

【実施例 4】

1-N-アシルアミノ-1-p-クロロフェニルエチレンのRh-触媒による水素付加反応

【化 2 5】



【誤訳訂正 7】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 6 2

【訂正方法】変更

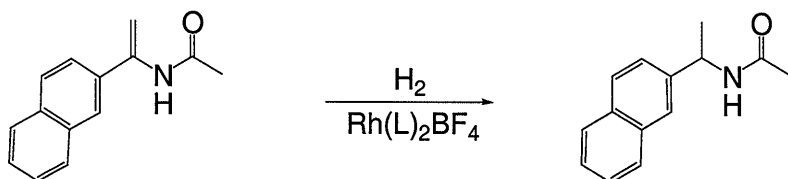
【訂正の内容】

【0 0 6 2】

【実施例 6】

I タイプの配位子を用いた1-N-アシルアミノ-1-ナフチルエチレンのRh-触媒による水素付加反応

【化 2 6】



【誤訳訂正 8】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 6 4

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0 0 6 4】

【実施例 7】

I タイプの配位子を用いたイタコン酸ジメチルのRh-触媒による水素付加反応

【化 2 7】

